

ESERCIZIO: QUASI DARLINGTON #1

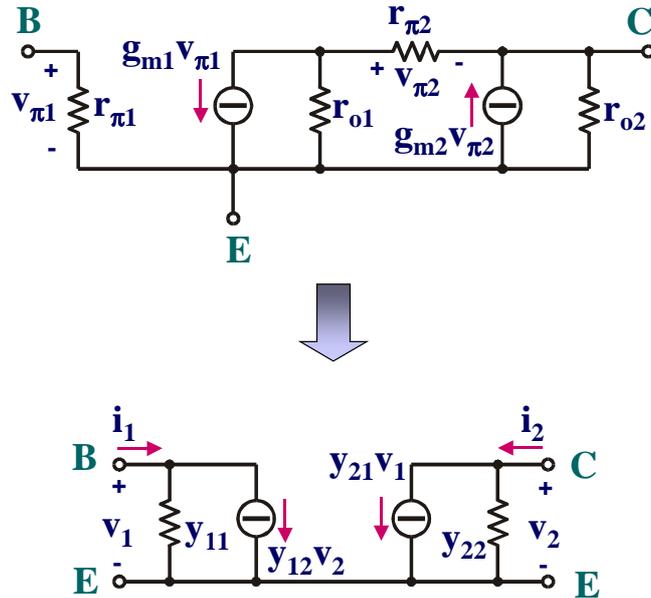


Figura 1

SOLUZIONE

Il modello ai piccoli segnali della connessione quasi darlington è riportato in figura 1, assieme alla rappresentazione equivalente a parametri $[y]$ caratterizzata dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} i_1 = y_{11}v_1 + y_{12}v_2 \\ i_2 = y_{21}v_1 + y_{22}v_2 \end{cases} \quad (1)$$

Dalla (1), si ricavano le seguenti definizioni dei parametri $[y]$:

$$y_{11} = \left. \frac{i_1}{v_1} \right|_{v_2=0} \quad (2.a)$$

$$y_{12} = \left. \frac{i_1}{v_2} \right|_{v_1=0} \quad (2.b)$$

$$y_{21} = \left. \frac{i_2}{v_1} \right|_{v_2=0} \quad (2.c)$$

$$y_{22} = \left. \frac{i_2}{v_2} \right|_{v_1=0} \quad (2.d)$$

Prima di procedere con il loro calcolo, ricaviamo i vincoli imposti dalla particolare connessione in oggetto ai parametri ai piccoli segnali di ciascun transistor. Per quanto riguarda il parametro transconduttanza possiamo scrivere:

$$I_{B2} = I_{C1} \Rightarrow I_{C2} = \beta_{F2} I_{B2} = \beta_{F2} I_{C1} \quad (3.a)$$

da cui,

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_T} = \frac{\beta_{F2} I_{C1}}{V_T} = \beta_{F2} g_{m1} \Rightarrow g_{m2} \approx \beta_{02} g_{m1} \quad (3.b)$$

Di conseguenza, le resistenze di ingresso devono soddisfare la seguente relazione:

$$r_{\pi2} = \frac{\beta_{02}}{g_{m2}} \approx \frac{1}{g_{m1}} = \frac{r_{\pi1}}{\beta_{01}} \quad (4)$$

Per quanto riguarda le resistenze di uscita possiamo scrivere:

$$r_{o1} = \frac{V_{CE1} + V_A}{I_{C1}} \approx \frac{V_A}{I_{C1}} = \frac{V_A}{I_{C2}} \frac{I_{C2}}{I_{C1}} \approx \beta_{02} r_{o2} \quad (5)$$

Per il calcolo dei parametri $[y]$, facciamo riferimento alle figure 3 e 4, nelle quali si è considerato $v_1 = 0$ e $v_2 = 0$ rispettivamente. Le espressioni approssimate ricavate in seguito considerano $\beta_0 \gg 1$.

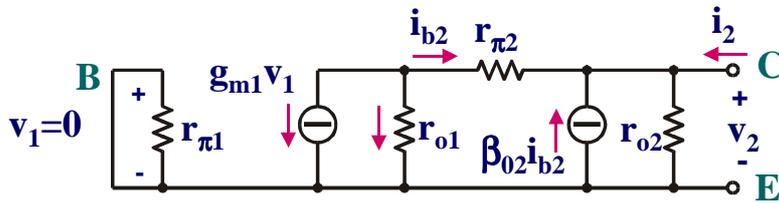


Figura 3

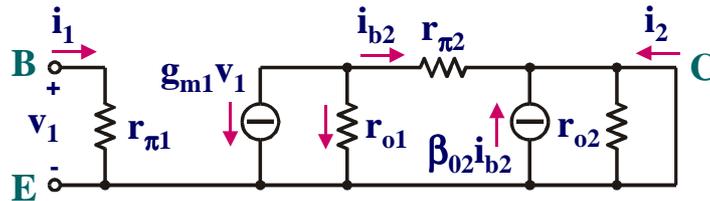


Figura 4

Determinazione di y_{11} :

Il parametro y_{11} rappresenta la conduttanza di ingresso quando viene annullata la tensione di uscita. Il circuito da analizzare è pertanto quello mostrato in figura 4 nel quale si è posto l'uscita in cortocircuito e si è applicato un generatore di tensione v_1 in ingresso. Da questo schema si calcola il rapporto i_1/v_1 come segue:

$$v_1 = r_{\pi1} i_1 \quad (6)$$

$$y_{11} = \frac{1}{r_{\pi1}} \approx \frac{1}{r_{\pi2} \beta_{01}} \quad (7)$$

dove si è fatto uso della (4).

Determinazione di y_{12} :

Il parametro y_{12} rappresenta la transconduttanza inversa quando viene cortocircuitata la porta di ingresso. Il circuito da analizzare è mostrato in figura 3. Da questo schema otteniamo:

$$i_1 = 0 \Rightarrow y_{12} = 0 \quad (8)$$

Determinazione di y_{21} :

Il parametro y_{21} rappresenta la transconduttanza diretta con l'uscita in cortocircuito. Per la sua determinazione si faccia uso della figura 4. Da questo schema calcoliamo:

$$i_2 = -(1 + \beta_{02}) i_{b2} \quad (9)$$

$$i_{b2} = -i_{o1} - g_{m1} v_1 \quad (10)$$

$$i_{o1} = \frac{r_{\pi 2} i_{b2}}{r_{o1}} \quad (11)$$

Sostituendo la (11) nella (10) otteniamo:

$$i_{b2} = -\frac{g_{m1}}{1 + \frac{r_{\pi 2}}{r_{o1}}} v_1 \quad (12)$$

che, sostituita nella (9) fornisce la seguente espressione (si utilizzi la (3.b)):

$$y_{21} = (1 + \beta_{02}) \left(\frac{g_{m1}}{1 + \frac{r_{\pi 2}}{r_{o1}}} \right) = \left(\frac{1 + \beta_{02}}{\beta_{02}} \right) \left(\frac{g_{m2}}{1 + \frac{r_{\pi 2}}{\beta_{01} r_{o2}}} \right) \approx \frac{g_{m2}}{1 + \frac{V_T}{V_A}} \approx g_{m2} \quad (13)$$

(Il potenziale termico V_T è, senza ombra di dubbio, ordini di grandezza inferiore alla tensione di early V_A).

Determinazione di y_{22} :

Il parametro y_{22} rappresenta la conduttanza di uscita quando viene cortocircuitata la porta di ingresso. Il circuito da analizzare rimane quello di figura 3. Possiamo scrivere:

$$y_{22} = \frac{1}{r_{o2}} + \frac{1 + \beta_{02}}{r_{o1} + r_{\pi 2}} \approx \frac{1}{r_{o2}} + \frac{1 + \beta_{02}}{\beta_{02} r_{o2} + r_{\pi 2}} \approx \frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o2} + \frac{r_{\pi 2}}{\beta_{02}}} = \frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o2} + \frac{1}{g_{m2}}} \approx \frac{2}{r_{o2}} \quad (14)$$

In definitiva, la connessione quasi darlington può essere trattata alla stregua di un singolo transistor avente il seguente modello ai piccoli segnali:

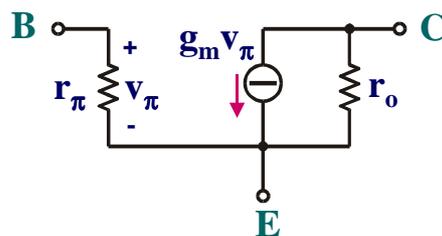


Figura 5

in cui i parametri valgono:

$$r_{\pi} \approx \beta_{01} r_{\pi 2} \quad (15.a)$$

$$g_m \approx g_{m2} \quad (15.b)$$

$$r_o \approx \frac{r_{o2}}{2} \quad (15.c)$$